

# 電気学会研究会資料目次

## 電子デバイス研究会

〔委員長〕 益 一哉（東京工業大学）

〔副委員長〕 上野和良（芝浦工業大学）

〔幹事〕 大見俊一郎（東京工業大学），荒川太郎（横浜国立大学）

〔幹事補佐〕 本間哲哉（芝浦工業大学）

日 時 平成19年3月1日（木） 14:00～17:00  
3月2日（金） 9:00～12:00

場 所 NTT水上保養所「紫明荘」（群馬県利根郡水上町湯檜曾15-1 JR上越線湯檜曾駅下車，  
1～2分または上越線水上駅下車，谷川ロープウェー行きバス10分，湯檜曾駅前下車。上越新幹  
線上毛高原駅下車，リレーバスにて水上駅下車。（水上駅からは谷川ロープウェー行きのバスと同様  
<http://www.hoyojo.nttkikinkenpo.or.jp/cgi-bin/info/main.cgi?SID=8014>）

### テーマ「超高速デバイス・回路技術」

- EDD-07-39 界面物理現象理解に基づいた Ni-FUSI/SiON 及び HfSiON 界面の実効仕事関数制御技術  
土屋義規，吉木昌彦（東芝）  
佐藤基之，関根克行，齋藤友博，中嶋一明，青山知憲（東芝）  
古賀淳二，西山 彰，小山正人（東芝） …………… 1
- EDD-07-40 SOI 基板上の Ni-FUSI/HfSiON MOSFET におけるしきい値電圧制御  
寺島浩一，間部謙三，高橋健介，渡部宏治，小倉 卓，西藤哲史，  
忍田真希子，五十嵐信行，辰巳 徹，渡辺啓仁（日本電気） …………… 7
- EDD-07-41 インバータ特性電流を用いた低消費電力 CMOS 回路用デバイス設計  
吉田英司，初山陽一，佐藤成生，杉井寿博（富士通研究所）  
宮本真人，斎木孝志，児島 学（富士通） …………… 13
- EDD-07-42 絶縁ゲートにより制御するホットエレクトロントランジスタの走行層幅微細化  
齋藤尚史，諏訪 輝，長谷川貴史，日野高宏，大野真也，五十嵐満彦（東京工業大学）  
宮本恭幸，古屋一仁（東京工業大学・JST-CREST） …………… 19
- EDD-07-43 InAlAs 障壁層薄層化による InP 系 HEMT のソース抵抗低減および  
相互コンダクタンス向上  
高橋 剛，牧山剛三，原 直紀（富士通） …………… 25

EDD-07-44	Si 基板上に MOCVD 成長した高品質 InAlN/GaN HEMT エピ 渡邊則之, 横山春喜, 廣木正伸, 小田康裕, 小林 隆 (日本電信電話) 八木拓真 (NTTアドバンステクノロジー) ……………	29
EDD-07-45	低ゲートリーク電流 Si イオン注入 GaN/AlGaIn/GaN HEMT の研究 野本一貴, 田島 卓, 佐藤政孝, 中村 徹 (法政大学) 三島友義 (日立電線) ……………	35
EDD-07-46	SiC 半絶縁性基板上へのイオン注入を用いた MESFET 作製 新井 学, 片上崇治, 尾形 誠, 小野修一 (新日本無線) ……………	39
EDD-07-47	広帯域無線アクセス用 3.3V 動作高出力低歪 GaAs HBT パワーアンプ技術 岡 徹, 平田倫歳, 長谷川正智, 天野義久, 石丸昌晃, 川村博史, 作野圭一 (シャープ) ……………	43
EDD-07-48	電磁界・半導体共シミュレーションによる表面波モード線路増幅モジュールの動作解析 石川 亮, 本城和彦 (電気通信大学) 中嶋政幸 (村田製作所) ……………	49
EDD-07-49	高誘電率樹脂基板上に作製した小型自己補対アンテナの特性 齊藤 昭 (ワイケーシー) 青木一浩, 本城和彦 (電気通信大学) 全 春虎, 渡部貢市 (ワイケーシー) ……………	55

協 賛 高度ワイヤレスユビキタス社会を支える超高速デバイス・回路技術調査専門委員会